

生産終了予定商品

フォト・マイクロセンサ

形EE-SY125
形EE-SY125-1**推奨代替商品**

フォト・マイクロセンサ

形EE-SY199
※2009年12月発売予定**2010年3月末生産終了予定****推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点**

配線接続(実装形態)、外形寸法に違いがありますので、推奨代替品による設計変更の際にはご注意ください。

また、形EE-SY199につきましては2009年12月発売予定ですが、実装、基板設計のご検討用などのためサンプルをご用意いたします。しかしながら数量によってはご提供にお時間がかかり、さらに有償となる場合もありますので、大変お手数ですが弊社営業担当者までお問い合わせください。

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形EE-SY199	◎	○	×	×	○	○	○

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

-：該当する仕様がありません

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形EE-SY125 形EE-SY125-1	形EE-SY199(2009年12月発売予定)

外形寸法

生産終了予定商品 形EE-SY125 (-1)	推奨代替商品 形EE-SY199 (2009年12月発売予定)

端子配置／配線接続

生産終了予定商品 形EE-SY125 (-1)	推奨代替商品 形EE-SY199 (2009年12月発売予定)										
<table border="1" data-bbox="491 1505 758 1659"> <thead> <tr> <th>端子記号</th> <th>名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>アノード</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>カソード</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>コレクタ</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>エミッタ</td> </tr> </tbody> </table>	端子記号	名称	A	アノード	K	カソード	C	コレクタ	E	エミッタ	
端子記号	名称										
A	アノード										
K	カソード										
C	コレクタ										
E	エミッタ										

梱包形態および最小発注単位

項目	生産終了予定商品		推奨代替商品
	形EE-SY125	形EE-SY125-1	形EE-SY199 (2009年12月発売予定)
梱包形態	50個/1スティック× 40本/アルミ防湿梱包	1000個/1リール 1リール/アルミ防湿梱包	2000個/リール 1リール/アルミ防湿梱包
最小発注単位	2000個	1000個	2000個

定格性能(Ta=25°C)

項目		生産終了予定商品 形EE-SY125 (-1)	推奨代替商品 形EE-SY199 (2009年12月発売予定)
発光側	順電流	50mA	50mA
	逆電圧	4V	6V
受光側	コレクタ・エミッタ間電圧	30V	35V
	エミッタ・コレクタ間電圧	5V	6V
	コレクタ電流	20mA	20mA
	コレクタ損失	75mW	75mW
動作温度		-25~+85°C	-25~+85°C
保存温度		-40~+100°C	-40~+100°C
はんだ付け温度		260°C 3秒以内(手はんだ) 240°C 10秒以内(リフロー)	260°C 5秒以内(手はんだ) 240°C 10秒以内(リフロー)

電気および光学的特性(Ta=25°C)

項目		生産終了予定商品 形EE-SY125 (-1)			推奨代替商品 形EE-SY199 (2009年12月発売予定)			
		特性値			特性値			
		MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.	
発光側	順電圧 V_F [V]	-	1.2	1.4	-	1.2	1.4	
			条件: $I_F=20\text{mA}$			条件: $I_F=20\text{mA}$		
	逆電流 I_R [μA]	-	0.01	10	-	-	10	
			条件: $V_R=4\text{V}$			条件: $V_R=6\text{V}$		
受光側	ピーク発光波長 λ_P [nm]	-	950	-	-	950	-	
			条件: $I_F=4\text{mA}$			条件: $I_F=4\text{mA}$		
	光電流 I_L [μA]	50	-	300	40	85	130	
			条件: $I_F=4\text{mA}$, $V_{CE}=2\text{V}$ 検出物体: アルミ蒸着ガラス 検出距離: 1mm			条件: $I_F=4\text{mA}$, $V_{CE}=2\text{V}$ 検出物体: アルミ蒸着ガラス 検出距離: 1mm		
受光側	暗電流 I_D [nA]	-	2	200	-	1	100	
			条件: $V_{CE}=10\text{V}$, 0lx			条件: $V_{CE}=20\text{V}$, 0lx		
	漏れ電流 I_{LEAK} [μA]	-	-	0.2	-	-	0.5	
			条件: $I_F=4\text{mA}$, $V_{CE}=2\text{V}$			$I_F=4\text{mA}$, $V_{CE}=2\text{V}$		
受光側	コレクタ・エミッタ間 飽和電圧 $V_{CE}(\text{sat})$ [V]	-	-	-	-	-	-	
受光側	上昇時間 t_r [μs]	-	35	-	-	20	100	
			条件: $V_{CC}=2\text{V}$, $R_L=1\text{k}\Omega$, $I_L=100\mu\text{A}$			条件: $V_{CC}=2\text{V}$, $R_L=1\text{k}\Omega$, $I_L=100\mu\text{A}$		
受光側	下降時間 t_f [μs]	-	25	-	-	20	100	
			条件: $V_{CC}=2\text{V}$, $R_L=1\text{k}\Omega$, $I_L=100\mu\text{A}$			条件: $V_{CC}=2\text{V}$, $R_L=1\text{k}\Omega$, $I_L=100\mu\text{A}$		